








	<h2 style="color: red;">IPD80R2K8CEBTMA1</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: IPD80R2K8CEBTMA1</p> <p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 800V 1.9A TO252-3</p> <p>Datenblätter:  IPD80R2K8CEBTMA1.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IPD80R2K8CEBTMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 800V 1.9A TO252-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3.9V @ 120µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-252-3
Serie	CoolMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2.8 Ohm @ 1.1A, 10V
Verlustleistung (max)	42W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	290pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	12nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	800V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	1.9A (Tc)

IPD80R2K8CEBTMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPD80R2K8CEBTMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPD80R2K8CEBTMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPD80R2K8CEBTMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IPD80R450P7ATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 800V 11A DPAK</p>	 <p>IPD80R3K3P7ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 800V 1.9A TO252-3</p>	 <p>IPD80R2K0P7ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 800V 3A TO252-3</p>	 <p>IPD80R360P7ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 800V 13A TO252-3</p>
 <p>IPD80R2K8CEATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 800V 1.9A TO252-3</p>	 <p>IPD80R2K7C3AATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH TO252-3</p>	 <p>IPD80R4K5P7ATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 800V 1.5A DPAK</p>	 <p>IPD80R2K8CE infineon IPD80R2K8CE infineon</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPD80R2K8CEBTMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPD80R2K8CEBTMA1 Datenblatt	IPD80R2K8CEBTMA1-Datenblätter	IPD80R2K8CEBTMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPD80R2K8CEBTMA1
IPD80R2K8CEBTMA1 Electronic	IPD80R2K8CEBTMA1-Komponenten	IPD80R2K8CEBTMA1-Verteiler	IPD80R2K8CEBTMA1-Bild	IPD80R2K8CEBTMA1-Teil
IPD80R2K8CEBTMA1 Preis	IPD80R2K8CEBTMA1 Hersteller	IPD80R2K8CEBTMA1 Bild	IPD80R2K8CEBTMA1 Aktie	IPD80R2K8CEBTMA1 Inventar
IPD80R2K8CEBTMA1 Neu	IPD80R2K8CEBTMA1 Original	IPD80R2K8CEBTMA1 garantiert	IPD80R2K8CEBTMA1 RFQ	IPD80R2K8CEBTMA1 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited